# بررسی گسیل میدانی نانو لولههای طبقهای CNT-TiO<sub>2</sub> تحت تابش نور

ياسر عبدی\*، حميدرضا عرب بافرانی، علی ساريخانی، مسعود قاسمی

ازمایشگاه نانوفیزیک،دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران، ایران دریافت: 1396/11/30 ویرایش نهائی: 1397/09/11 پذیرش: 1397/12/25

### چکیدہ

امروزه چشمههای الکترونی بر پایهٔ گسیل میدانی، نقش قابل توجهی در بخشهای مختلف زندگی ما ایفا میکنند. از جمله مهمترین کاربردهای گسیل میدانی میتوان بهمیکروسکوپهای الکترونی، نمایشگرهای گسیل میدانی و سلولهای خورشیدی اشاره کرد. نانولولهها بهعنوان گسیلندهٔ الکترونی، در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. در این میان، نانولولههای کربنی بهعلت دارا بودن بدنهٔ رسانا، بهعنوان یکی از بهترین گسیلندههای میدانی شناخته میشوند. همچنین نانولولههای دی اکسید تیتانیوم بهدلیل خاصیت اکسیدی و نیز قابلیت رشد بر روی زیر لایهٔ رسانا، از جمله گسیلندههای خوب میدانی هستند. هدف این پژوهش، یافتن ساختاری با گسیل میدانی بالا، به کمک بررسی گسیل میدانی حاصل از ساختارهای نانولوله دی اکسید تیتانیوم، نانوساختارهای متشکل از نانولولههای دی اکسید تیتانیوم و نانو لولههای کربنی و نهایتاً این نانو ساختارهای دو طبقه تحت تابش نور میباشد. در این پژوهش، مشاهده شد که ساختارهای دو طبقهای گسیل الکترونی بهمراتب بیشتری نسبت به ساختارهای معمولی داشتند و

كليدواژ گان: نانولوله هاى TiO2، نانولوله هاى كربنى، گسيل الكترون

#### مقدمه

گسیل میدانی، مکانیسمی برای خارج کردن الکترونها از سطح اجسام با پدیدهٔ تونلزنی در حضور میدان الکتریکی خارجی است. اگر یک مادهٔ جامد در معرض یک میدان الکتریکی با شدت مناسب قرار داده شود، الکترونهای نزدیک بهتراز فرمی در آن میتوانند از طریق پدیدهٔ تونل زنی از درون سد پتانسیل، سطح را ترک کنند. از جمله ویژگیهای مهمی که در ادوات گسیل میدانی قابل توجه است، میزان ثابت بودن و پایداری گسیلنده است. از مهمترین ساختارهایی که برای مقاصد گسیل میدانی مناسب میباشند، نانولولهها

هستند، چرا که از نسبت طول بهقطر بسیار زیادی برخوردار هستند [1].

نانولولههای دی اکسید تیتانیوم از روشی تولید می شوند که در سال **1999** زویلینگ و همکاران برای نخستین بار تولید لایهٔ متخلخل TiO<sub>2</sub> روی زیر لایهٔ تیتانیوم در ولتاژ پایین را گزارش دادند [2]. مزایای دی اکسید تیتانیوم همچون حساسیت زیاد به نور، پایداری نسبی تحت تابش نور و نیز قیمت مناسب باعث شده است که یکی از کاندیداهای مناسب برای گسیل میدانی باشد [3].

از طرف دیگر، ساختارهای بس اتمی کربن، با آرایشهای مختلف که آلوتروپ نامیده می شوند، دارای

\*نويسندهٔ مسئول: y.abdi@ut.ac.ir

باز نشر این مقاله با ذکر منبع آزاد است. <u>۲۳ (۲۰)</u>این مقاله تحت مجوز کرینیو کامنز تخصیص 4٫0 بینالمللی می،شد

خواص منحصر بەفردى هستند. معروف ترين آلوتروپهای کربنی شامل کربن بینظم، گرافیت، الماس و آلوتروپهای جدید مانند باکیبالها، گرافن، نانوفيبرها و نانولولههای کربنی (CNT) هستند [4]. هرکدام از این آلوتروپها دارای خواص منحصر بهفردی می باشند و محققان زیادی را به خود مشغول كردهاند. این آلوتروپها از نظر الكتریكی خواص جالب و متفاوتی را از خود نشان میدهند بهطوریکه می توانند نارسانا، نیمرسانا، رسانا و یا حتی شبهفلز شوند [5]. در این بین نانولولههای کربنی که مانند صفحات لوله شده گرافین هستند، با خواص ویژهشان از جمله پایداری، رسانندگی حرارتی و الکتریکی عالی، نسبت سطح به حجم بالا، تحمل استرس های مکانیکی و غیره توانستهاند جایگاه خاصی را بهدست بیاورند. نانولولههای کربنی در بیشتر تحقیقات بهخاطر رسانندگی بالایی که دارند بهعنوان یک کانال ویژه عبور الكترونها بهكار ميروند.

از نظر زمانی، در سال 1999 زویلینگ و همکاران برای نخستین بار تولید لایهٔ متخلخل TiO<sub>2</sub> روی زیرلایه تیتانیوم در ولتاژ پایین را گزارش دادند [2]. پس از آن در سال 2001 گروه گریمس توانستند با استفاده از محلول حاوی HF نخستین لایهٔ نانولولهٔ دیاکسید تیتانیوم بهضخامت حدود نیم میکرومتر را تولید کنند [6].

با کشف نانولولههای کربنی در سال 1991 توسط ایجیما اندیشهٔ استفاده از نانو لولهها و نانو ذرات بهخاطر داشتن خواص شیمیایی و فیزیکی منحصر بهفردشان بهذهن دانشمندان خطور کرد. کوچک کردن ادوات در الکترونیک و سایر محصولات تکنولوژی نقش بهسزایی در دوام و کارایی این محصولات دارد [7]. از نانولولههای کربنی در حوزههای مختلفی

همچون ساخت حسگرهای مولکولی [8]، ترانزیستورهای اثرمیدانی [9] و نیز سلولهای خورشیدی رنگدانهای [10] استفاده می شود. با پیشرفت تکنولوژی و نیاز بشر بهابزارهای دقیق تر، روش های متفاوتی برای رشد نانولولهها و نانوذرات ابداع شد. برای رشد نانولولههای کربنی روش های مختلفی ارائه شده است، که می توان به روش تخلیهٔ قوس الکتریکی، سایش لیزری، رسوب شیمیایی از فاز بخار، الکترولیز و استفاده از انرژی خورشیدی اشاره کرد [11]. در اینجا پلاسما (PECVD) استفاده شده است که روش مفیدی برای تولید انبوهی از نانولولههای به خط شده و منظم است [12].

در اینجا علاوه بر بهره گیری از خواص نانولولههای کربنی، سعی در استفاده از پیوندگاه بین نانولولههای کربنی و دی اکسید تیتانیوم شده است تا بتوان گسیل الکترونی را افزایش داد. استفاده از کامپوزیتهای حاوی نانولولهٔ کربنی برای جدایش بارها می تواند به این مشکل غلبه کند، مثلاً کامپوزیت CNT-TiO2 می تواند گسیل میدانی را افزایش دهد [13]. تحقیقاتی بر روی کامپوزیتهای TiO2-MWCNT (نانو لولههای کربنی چند دیواره) انجام شدهاند و نشان دادهاند که طول عمر الکترون در اثر استفاده از نانولولههای کربنی چند جداره افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر جریان را نیز بهبود می دهد [15\_14].

مورد دیگری که به افزایش گسیل میدانی کمک میکند و در سالهای اخیر گزارش شده است [16]، استفاده از تابش نور به نانوساختارهای کربنی جهت افزایش گسیل میدانی است، مثلاً نوژه و همکاران نشان دادند که تابش نور IR به نانولولههای کربنی به دلیل ایجاد تله گرمایی باعث افزایش جریان الکترونی گسیلی به روش گسیل

یون-گرمایی می شود، و یا منشی پوری و همکاران نشان دادند که با تابش نور مرئی به نانولوله های کربنی که با نانوذرات پلاسمونی پوشیده شده اند، باعث افزایش جریان گسیل الکترون می شود [17]. روش دیگر به دام اندازی نور، ایجاد اصلاحات درون ساختار متخلخل است. در خلال انجام این پروژه و تحقیق روی نانولوله های دی اکسید تیتانیوم موفق به دستیابی به ساختار جدیدی شدیم که رفتاری مشابه با بلورهای فوتونی را از خود بروز می داد.

با توجه بهاینکه ساختارهای سهبعدی دی اکسید تیتانیوم میتواند با بهدام انداختن نور درون خود، مسیر پیموده شده توسط نور را افزایش دهد و باعث تحریک بیشتر الکترونها شود، تصمیم گرفته شد که نهایتاً این نانو ساختارها تحت تابش نور مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد.

# کارهای آزمایشگاهی

توليد نانو ساختارهاي TiO<sub>2</sub>

رشد نانولولههای دی اکسید تیتانیومی از روش آندی شدن انجام شده است که در سال 2001 گروه گریمس توانستند با استفاده از محلول حاوی HF نخستین لایه نانولوله دی اکسید تیتانیوم به ضخامت حدود 500 نانومتر را تولید کنند [6]. در عمل، برای انجام فرآیند آندی شدن از محلولهای الکترولیت متفاوتی استفاده می شود. محلولی که برای تولید این نانولولهها به کار گرفته شد حاوی آب دیونیزه، اتیلن گلیکول و نمک آمونیم فلورید است [6]. الکترولیت نقش مهمی در مورفولوژی نانولولههای دی اکسید تیتانیوم دارد. محلول الکترولیت به حجم 300 میلی لیتر تولید شدند که مادهٔ اصلی در این محلول اتیلن گلیکول است و دیگری آب

محلولها می تواند متفاوت باشند. این محلول حاوی 1گرم آمونیوم فلوراید است.

در مرحلهٔ بعد، برای ایجاد ساختارهای سه بعدی از دو مرحلهٔ آندی شدن استفاده کردیم که زاویههای بین دو الکترود در این دو مرحله با یکدیگر متفاوت بودند. پس از رشد عمودی نانولولههای دی اکسید تیتانیوم از طریق موازی هم قرار دادن دو الکترود، در مرحلهٔ بعد با ایجاد زاویه بین دو الکترود حفرههایی در راستای دوم در جدارهٔ نانولولههای مرحلهٔ اول بهوجود آمد. این ساختارها شامل دو آرایه از حفرهها هستند که اولاً محور استوانهٔ این دو آرایه نسبت بههمدیگر زاویه دارند و ثانیاً محلهای تقاطع این دو آرایه استوانهای تولید ساختار سه بعدی متناوب میکند که می توانند مانند یک بلور فوتونی سه بعدی رفتار کنند، یعنی تولید یک ناحیهٔ ممنوعه برای عبور فوتونهای با طول موج معین.

### رشد نانو لوله های کربنی

برای رشد نانولولههای کربنی از روش رسوب بخار شیمیایی به کمک پلاسما (PECVD) استفاده شده است. از مهمترین خصوصیات این روش، رشد نانولولههای کربنی عمودی بدون نیاز به دمای بالا می باشد. برای رشد دادن نانولولههای کربنی از زیر لایهٔ سیلیسوم استفاده کردیم. همچنین از فلز نیکل به عنوان کاتالیست استفاده شد. لایهٔ نازکی از این کاتالیست به ضخامت حدود 10 نانومتر به روش لایه نشانی تبخیر فیزیکی بر روی زیرلایه قرار داده شد. زیرلایهٔ سیلیسیوم لایه نشانی شده با نیکل در دستگاه PECVD قرار داده شد تا رشد نانولولههای کربنی در آن انجام شود. رشد نانولولهها در دمای 700 درجه سیلسیوس و در فشار 2 تور انجام شد. توان پلاسمای اعمالی 4 وات بر سانتیمتر مربع و به مدت 30 دقیقه بود. گازهای مورد استفاده

هیدروژن بهعنوان گاز حامل و استیلن بهعنوان منبع کربنی بود .

# ایجاد نانوساختارهای طبقهای و آنالیزها

برای ایجاد نانوساختارهای طبقهای روی نانوساختارهای TiO2 بهمیزان 20نانومتر نیکل لایه نشانی شد. سپس نمونه در دستگاه PECVD قرار گرفته و نانولولهٔ کربنی بهروش اشاره شده در بخش قبل، رشد داده شد.

به منظور آنالیز ساختاری از دستگاه میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی (FESEM-4160,) مد تصویر برداری الکترون ثانویه استفاده شد. (Ava Spec 1024) با دستگاه (Ava Spec 1024) انالیزهای اپتیکی با دستگاه (Ava Spec 1024) انجام شده است. همچنین به منظور اندازه گیری گسیل الکترونی از ساختارهای رشد داده شده از دستگاه (IVmeter, Raga 10A)

# نتايج و بحث

تصاویر میکروسکوپ الکترونی نانولولههای دی اکسید تیتانیوم رشد داده شده در شکل1 آمده است. شکل الف تصویر از بالای نانولولههای عمودی را نشان میدهد. شکلب همین نمونه را از نمای پهلو نشان میدهد و شکلپ نانولولههای با ساختار سه بعدی را از پهلو نشان میدهد که نشان میدهد در دیوارهٔ نانولولههای دی اکسید تیتانیوم نیز زدایش انجام شده است. نمونهٔپ نتیجه آندی شدن در چند زاویه است که در بخش جزئیات آزمایش راجع به آن توضیح داده شد.

شکل2 تصویر SEM نانوساختارهای دو طبقهای TiO<sub>2</sub>/CNT را نشان میدهد. همانطور که در شکل دیده می شود، نانولوله های کربنی به طور کاملاً عمودی بر روی نانوله های TiO<sub>2</sub> رشد کرده اند. این مسأله برای

داشتن گسیل الکترونی مناسب بسیار اهمیت دارد. تصاویر میکروسکوپی آورده شده در این مقاله نمونههایی است از ساختارهای بسیاری که در این کار رشد داده شدهاند. کنترل قطر و ارتفاع نانولولههای کربنی و نانولولهای TiO<sub>2</sub> با کنترل پارامترهای رشد امکان پذیر بوده است. که نتایج همهٔ آنها در این مقاله آورده نشده است.







شکل 1. الف: نمای از بالای نانولههای TiO2 ب: نمای از پهلوی نانولولههای TiO2 پ: نمای از پهلوی نانولولههای TiO2 چند مرحلهٔ آندی شده. مقیاسها در تصاویر به ترتیب 500 000 و 300 نانومتر است.



شکل2 تصویر SEM نانوساختارهای دو طبقه ای SEM

جهت بررسی گسیل میدانی نانوساختارهای رشد داده شده از یک چیدمان خلأ استفاده شد که خلأ آن تا 10 تور پايين مي آمد و اتصالات تو گذر خلأ براي اتصال دهی الکتریکی به ساختارها در آن تعبیه شده بود. نتایج گسیل میدانی نانوساختارها در شکل3 آمده است. با توجه بهاینکه آلاییده شدن نانولولههای دی اکسید تيتانيوم با كربن مي تواند رسانندگي آنها را بالا ببرد، و بهجهت اینکه بتوانیم اثر نانوساختار چند طبقهای را با اثر آلاييده شدن نانولوله هاي TiO2 تفكيك كنيم، نمونه آلاییده شده را نیز در اندازهگیری گسیل میدانی وارد کردیم. همانطور که در نمودارهای شکل3 دیده میشود، با آلایش نانولولههای TiO<sub>2</sub> گسیل الکترون آنها افزایش پیدا کرده است و با رشد نانولولههای کربنی روی آنها این جریان افزایش چشمگیری داشته است. برای مقایسهٔ بهتر نتایج بهدست آمده، گسیل میدانی نانولولههای رشد داده شده روی ورقهٔ تیتانیوم نیز در شکل3 آمده است. نتایج نشان میدهد که ساختار طبقهای بهترین گسیل میدانی را دارد.



**شکل3.** نمودار جریان برحسب ولتاژ برای چهار نانوساختار مختلف. منحنی قرمز رنگ مربوط بهنانوساختار چند طبقه، منحنی سبز رنگ مربوط بهنانولولههای کربنی، منحنی سیاه رنگ مربوط بهنانولولهٔ دیاکسید تیتانیوم آلاییده شده با کربن و منحنی آبی رنگ مربوط به نانولوله دیاکسید تیتانوم خالص میباشند.

قبل از بررسی تأثیر تابش نور بر گسیل الکترونی ساختارهای تولید شده، ابتدا بهبررسی برهمکنش نور با نانولولههای TiO<sub>2</sub> پرداخته شد. شکل4 شدت نور پراکنده شده از نانولولههای TiO<sub>2</sub> را تحت تابش نور فرابنفش (350 نانومتر) برحسب زاویه نشان میدهد. برای این منظور با استفاده از فیبر نوری نور فرودی در راستای عمود بر نمونه تابانده می شود و با استفاده از یک فیبر نوری دیگر که به نقالهٔ متحرکی وصل است در زوایای مختلف نور پراکنده شده جمع آوری می شود. نور وارد شده بهفیبر نوری با استفاده از دستگاه (Ava Spec 1024) شدت سنجي شد. در شکل4 نمودار الف (قرمز رنگ) مربوط بهنانولولهای است که در دو مرحلهٔ آندی شده است و نمودار ب (آبی رنگ) مربوط به نانولولهای است که بهصورت تک مرحلهای آندی شده است. همانطور که دیده می شود، نانولولهٔ دو مرحلهای دارای دو قله در نمودار پراکندگی است. نمودار پراکندگی برحسب زاویه برای یک ساختار عمودي برحسب زاویه كاهش پیدا ميكند. كه اين رفتار معمولاً با نسبت كسينوس زاويه كاهش پيدا ميكند. اما در ساختار دو مرحلهای با توجه بهاینکه زاویه ارجح دیگری هم برای پراکندگی وجود دارد، ما در نمودار یراکندگی دو قله می بینیم که این رفتار مشابه رفتار

بلورهای فوتونی است، که در آنها پراکندگی بدین ترتیب بهزاویه وابسته است.



**شکل4.** نمودار شدت پراکندگی برحسب زاویه برای نمونههای [الف) دو مرحلهای و (ب) تک مرحله. این منحنیها مربوط به نور فرودی با طول موج 350 نانومتر میباشد.

در مطالعهٔ دیگری آزمایش مربوط به شکل 4 با طول موجهای مختلف امتحان شد. نتایج این اندازه گیری در شکل 5 آمده است. همان طور که در این شکل دیده می شود، رفتار مشابهی برای نانولوله های دو مرحلهای در طول موجهای مختلف اتفاق می افتد. البته شدت پراکندگی در طول موجهای بزرگتر کمتر است. این مسأله نیز قابل پیش بینی بود. چرا که طول موجهای بزرگتر ساختار نانومتری آرایه های نانولوله را نمی بیند.



شكل5. منحنى شدت پراكندگى برحسب زاويه براى طول موجهاى مختلف. الف: 350 نانومتر، ب: 450 نانومتر، ج: 550 نانومتر، د: 660. نانومتر و ه: 720 نانومتر.

جهت بررسی تأثیر نور بر گسیل الکترونی نانوساختارهای دو طبقهای، در حین انجام تست گسیل الکترونی به آنها نور تابانده شد. برای این منظور از شیشه لايەنشانى شدە با FTO بەعنوان رساناى شفاف براى آند استفاده شد. در این اندازهگیری در ولتاژ ثابت جریان گسیلی برحسب زمان اندازهگیری و بهساختار نور تابانده و قطع شد. نتایج این اندازه گیری در شکل6 برای تابش نور با زاویههای مختلف آمده است. همان طور که مشاهده می شود، با تابش نور، گسیل الکترونی بین نانوساختارها و آند رسانای شفاف که در فاصلهٔ 1 میلیمتری از آن قرار داشته است افزایش مى يابد. اين تغيير در جريان الكتروني بهدليل برهم كنش نور با نانولولههای TiO<sub>2</sub> است. با تابش نور بهاین ساختارها به تلهاندازی انرژی اتفاق می افتد که نتیجهٔ آن این است که بهصورت موضعی نانوساختارها گرم میشوند. در اثر گرم شدن نانوساختارها بهگسیل الكتروني بهصورت گسيل گرمايوني افزايش مي يابد.



بررسی گسیل میدانی نانو ساختار...

[2] V. Zwilling, E. Darque-Ceretti, A. Boutry-Forveille, D. David, M.Y. Perrin, M. Aucouturier, Structure and Physicochemistry of Anodic Oxide Films on Titanium and TA6V Alloy, *Surface and interface analysis*, 27 (1999) 629-637.

[3] X. Xu, C. Tang, H. Zeng, T. Zhai, S. Zhang,; H. Zhao, Y. Bando, D. Golberg, Structural Transformation, Photocatalytic and Field-Emission Properties of Ridged TiO<sub>2</sub> Nanotubes, *Applied Materials & Interfaces*, 3 (2011) 1352– 1358.

[4] F. Diederich, Y. Rubin, Synthetic Approaches toward Molecular and Polymeric Carbon Allotropes, *Angewandte Chemie International Edition*, 31(1992) 1101-1123.

[5] R. Basuand, G.S. Iannacchione, Highresolution dielectric spectroscopy and electricfield dependence of carbon allotropes including multiwall and single-wall nanotubes, *Applied physics letters*, 92 (2008) 052906-9.

[6] D. Gong, C.A. Grimes, Titanium oxide nanotube arrays prepared by anodic oxidation, *Journal of Materials Research*, 16 (2001) 3331-3334.

[7] I. Sumio, Helical microtubules of graphitic carbon, *Nature*, 354 (1991) 56–58.

[8] J. Wang, Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review, *Electroanalysis*, 17 (2005) 7-14.

[9] P. Prakash, K.M. Sundaram, M.A. Bennet, A review on carbon nanotube field effect transistors (CNTFETs) for ultra-low power applications, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 89 (2018) 194-203.

[10] K.T. Dembele, R. Nechache, L. Nikolova, A. Vomiero, C. Santato, S. Licoccia, Rosei Effect of multi-walled carbon nanotubes on the stability of dye sensitized solar cells, *Journal of Power Sources*, 233 (2013) 93-97.

[11] J. Prasek, J. Drbohlavova, J. Chomoucka, J. Hubalek, O. Jasek, V. Adam, R. Kizek, Methods



شکل6. نمودارهای جریان گسیلی برحسب زمان در حین تابش نور با زوایای مختلف. با تابش نور جریان الکترونی افزایش و با قطع آن کاهش پیدا کرده است. در هر کدام از اندازه گیریها قطع و وصل نور دو بار انجام شده است.

# نتيجه گيري

در این پژوهش نشان دادیم که با قرار دادن نانولولههای کربنی بر روی نانولولههای دیاکسید تیتانیوم میتوانیم گسیل الکترونی چند برابری داشته باشیم. همچنین دیدیم که با زدایش دو مرحلهای سه تیتانیوم بهروش آندی شدن میتوانیم ساختارهای سه بعدیای ایجاد کنیم که در برهمکنش با نور مشابه بعدیای ایجاد کنیم که در برهمکنش با نور مشابه بورهای فوتونی رفتار میکنند. از این برهمکنش بهره بردیم و تأثیر تابش نور بر گسیل الکترونی نانوساختارهای دو طبقهای 20T/TiO را مورد مطالعه قرار دادیم. بررسی ما نشان داد که با تابش نور بهاین ساختارها میتوانیم افزایش چشمگیری در گسیل الکترونی این ساختارها ایجاد کنیم.

مرجعها

[1] Y. Chen, D.T. Shaw, Field emission of different oriented carbon nanotubes, *Applied Physics Letters*, 76 (2000) 2469-2472.

[15] C.Y. Yen, Y.F. Lin, S.H. Liao, C.C. Weng, C.C. Huang, Y.H. Hsiao, C.M. Ma, M.C. Chang, H. Shao, M.C. Tsai, Preparation and properties of a carbon nanotube-based nanocomposite photoanode for dye-sensitized solar cells, *Nanotechnology*, 19 (2008) 375305-9.

[16] P. Yaghoobi, M. Vahdani Moghaddam, A. Nojeh, Heat trap: light-induced localized heating and thermionic electron emission from carbon nanotube arrays, *Solid State Communications*, 151(2011) 1105-1108.

[17] M. Monshipouri, Y. Abdi, S. Darbari, Realization of low power-laser induced thermionic emission from Ag nanoparticle decorated CNT forest: A consequence of surface plasmon resonance, *Applied physics letters*, 109 (2016) 203105-8. for carbon nanotubes synthesis:review, *Journal* of Materials Chemistry, 21 (2011) 15872-15884.

[12] Y. Abdi, J. Koohsorkhi, J. Derakhshandeh, S. Mohajerzadeh, H. Hoseinzadegan, M.D. Robertson, J.C. Bennett, X. Wu, H.Radamson, PECVD-grown carbon nanotubes on silicon substrates with a nickel-seeded tip-growth structure, *Materials Science and Engineering C*, 26 (2006)1219–1223.

[13] P. Brown, K. Takechi, P.V. Kamat, Single-Walled Carbon Nanotube Scaffolds for Dye-Sensitized Solar Cells, *Journal of Physical Chemistry C* 112 (2008) 4776-4782.

[14] K.M. Lee, C.W. Hu, H.W. Chen, K.C. Ho, Incorporating carbon nanotube in a lowtemperature fabrication process for dyesensitized TiO<sub>2</sub> solar cells, *Solar Energy Materials & Solar Cells*, 92 (2008) 1628–1633.

95